

Ficha Técnica Memoria RAM

Memoria RAM LPDDR4 SK Hynix ATNN2G32L5A-NYF BGA200 / H54G68CYRBX248 BGA200

Capacidad de 8 GB

Temperatura de operación de -25°C ~ 85°C

Temperatura de almacenaje de -40°C ~ 85°C

VDD1 = 1,8 V (1,7 V a 1,95 V)

VDD2 = 1,1 V (1,06 V a 1,17 V)

VDDQ = 0,6 V (0,57 V a 0,65 V)

ODT de CA y ODT de DQ programables con terminación a VSSQ

Controlador de salida compensado VOH

Entrada de comandos y direcciones a velocidad de datos simple (SDR)

Arquitectura de doble velocidad de datos (DDR) para el bus de datos; dos accesos a datos por ciclo de reloj

Entradas de reloj diferencial (CK_t, CK_c)

Señal estroboscópica de datos diferencial bidireccional (DQS_t, DQS_c)

Soporte de pin DMI para enmascaramiento de datos de escritura y funcionalidad DBI_{dc}

RL (latencia de lectura) y WL (latencia de escritura) programables

Longitud de ráfaga: 16 (predeterminado), 32 y "On-the-fly" (dinámica)

El modo "On-the-fly" se habilita mediante MRS

Soporte para autorrefresco y autorrefresco autónomo (self-refresh)

Soporte para autorrefresco de todos los bancos y autorrefresco dirigido por banco

TCSR automático (autorrefresco con compensación de temperatura)

PASR (autorrefresco de matriz parcial) mediante máscara de banco y máscara de segmento

Calibración ZQ en segundo plano